

# 一般社団法人 GaN コンソーシアム 第1回スプリングスクール開催ご案内

2020年1月

GaN コンソーシアム

GaN コンソーシアムは、産学官の共創場での実践的教育を通して、高い専門性と俯瞰的な視点を兼備し、社会のための科学 (Science for Society) を志向する、21世紀型の若手研究者・技術者の育成に努めることにしています。これを踏まえて、我が国の GaN 研究開発の将来を担う優秀な人材を育成するため、昨年までに開催した GaN 研究コンソーシアム 3 回のスクールを引き継ぐ形でスプリングスクールを開講します。本年は基礎的知識の修得を目的とした講義と光デバイス・システム領域の基礎研究から実用化開発に関する講義を中心とするプログラムといたします。

- ◆開催日 2020年3月26日(木)・27日(金)
- ◆場 所 名古屋大学(東山キャンパス)アジア法交流館2F(地図中C5③)レクチャールーム1  
<http://www.nagoya-u.ac.jp/access-map/higashiyama/congre.html>
- ◆対象者 GaN コンソーシアムの会員である機関に所属する方(特に若手)  
※会員ではない機関からの参加希望があった場合、会員機関の参加を優先いたします。
- ◆募集人数 50名
- ◆募集期間 2020年3月13日(金)まで  
※応募者が定員に達した場合、募集を締め切ります。
- ◆参加費 《GaN コンソーシアムの会員機関》 無料  
※大学院生は交通費・宿泊費を補助します(各機関2名まで、最大3万円/人)  
《GaN コンソーシアムの会員ではない機関》 一人 5万円
- ◆プログラム 【別紙1】を参照ください。  
スクール長 天野 浩 名古屋大学 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授・センター長
- ◆参加申し込み方法  
下記事務局に、電子メールでご連絡ください。  
申し込みの際は、①参加者氏名 ②所属機関 ③職業(学生または役職) ④年齢 ⑤連絡先(電話番号とメールアドレス) ⑥交流会(参加費別途¥3,000(学生¥2,000))参加の可否 を明記ください。

個人情報をも本スクール参加登録以外の目的で使用すること、及び第三者に提供することはありません。

【申込み・問い合わせ先】(一社) GaN コンソーシアム事務局

E-MAIL: [info@gan-conso.jp](mailto:info@gan-conso.jp) (電話 050-3625-7503)

担当: 杉山、玉谷、水野、藤本、山口

## GaN コンソーシアム

### 第 1 回 スプリングスクール プログラム

【第一日目】 3月 26 日(木) GaN 基礎、光デバイス基礎および応用技術

(氏名は敬称略)

時 間	内 容	講 師
9:00~9:05	スクール長 挨拶	天野 浩 (名大)
9:05~9:10	オリエンテーション (趣旨、スケジュール)	事務局
9:10~10:30	GaN 概論 (材料物性・電子物性評価)	須田 淳 (名大)
10:30~10:40	(ブレイク)	
10:40~12:00	光デバイス結晶成長	竹内 哲也 (名城大)
昼 食 (各 自)		
13:00~14:20	光デバイスプロセス	上山 智 (名城大)
14:20~14:30	(ブレイク)	
14:30~15:50	光デバイス材料評価	秩父 重英 (東北大)
15:50~16:00	(ブレイク)	
16:00~17:20	光デバイス応用	杉谷 晃彦 (ウシオオプトセミコンダクター)
17:40~19:00	交流会 (名大内 CAFÉ BLANC にて)	

【第二日目】 3月 27 日(金) パワーエレクトロニクス、高周波デバイス・回路

時 間	内 容	講 師
9:00~10:20	パワーエレクトロニクスデバイス基礎	加地 徹 (名大)
10:20~10:30	(ブレイク)	
10:30~11:50	パワーエレクトロニクス回路基礎	今岡 淳 (名大)
昼 食 (各 自)		
13:00~14:20	高周波デバイス基礎	分島 彰男 (名工大)
14:20~14:30	(ブレイク)	
14:30~15:50	高周波回路基礎	原 信二 (名大)
15:50~16:20	修了式	